

# 반도체, 합종연횡 판도변화 가시화

## 3월3일 Nanya-Micron 공동 기술개발 발표 ... 삼성전자는 발 묶여

Sony와 Sharp의 합작투자가 발표된 LCD 시장에 이어 반도체 시장에서도 판도 변화가 가시화되고 있다. 관련업계에 따르면, 2007년 이후 적자에 허덕이고 있는 D램 후발기업들이 세력을 새롭게 규합하기 위한 합종연횡을 시작했다.

그러나 반도체 시장 격변기에 삼성전자는 후발기업들의 도전에 직면하고도 특검 수사에 발이 묶여 당장 2008년 사업계획도 짜지 못하고 있어 우려가 높아지고 있다.

타이완의 반도체 생산기업인 Nanya는 3월3일 자사 홈페이지를 통해 미국의 Micron과 50나노 이하 D램 생산을 위한 공동 기술 개발과 관련한 협약을 맺었다고 밝혔다.

2월 초부터 Micron과 Nanya가 합작법인을 설립한다는 루머가 파다했지만 해당기업들은 발표 전날까지 노코멘트나 부인으로 맞서다 전격 공동 기술개발을 발표했다.

Nanya가 Micron과 손을 잡았다는 것은 반도체 제조방식을 기준으로 한 분파인 트렌치(Trench) 계열에서 스택(Stack) 계열로 옮겨간다는 뜻이다.

트렌치는 웨이퍼 아래를 파서 막을 쌓는 회로 방식으로, 삼성전자나 하이닉스가 택하고 있는 스택(웨이퍼 위로 막을 쌓아올리는 방식)과 달리 미세회로 공정 전환에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

Nanya는 독일의 Qimonda와 트렌치 계열에 속했고, 스택과 트렌치 계열은 생산량을 기준으로 세계 반도체 시장에서 8대2의 비율로 나누어져 있었다.

Nanya가 스택 계열의 Micron과 손을 잡게 됨에 따라 가뜩이나 상황이 좋지 않았던 트렌치 계열의 이탈이 가속화될 전망이다.

그러나 기존 트렌치 계열도 한계를 극복하기 위한 새로운 공법을 내놓고 역전을 노리고 있다.

Qimonda는 최근 트렌치 공법을 대체할 새 D램 공법인 베리드 워드라인(Buried Wordline)을 도입한다고 발표했다. 양산 여부는 현재로선 불투명하지만 Qimonda는 30나노의 초미세 공정까지 실현할 수 있다고 주장하고 있다.

또 하이닉스와 제휴관계를 맺고 있는 타이완의 ProMOS도 최근 행보가 불안하다.

최근 발표된 아이서플라이 보고서에 따르면, 반도체 업계에서는 일본의 엘피다와 타이완 ProMOS가 파트너십을 체결할 수 있다는 루머가 파다하다.

특히, 하이닉스의 60나노급 D램 기술의 ProMOS로의 이전이 계속 연기되고 있어 기술력 업그레이드가 시급한 ProMOS로서는 배를 갈아탈 수 있다는 분석이 힘을 얻고 있다.

ProMOS는 60나노급 이하의 더욱 미세한 공정 기술 이전을 요구하고 있는 것으로 알려졌지만 하이닉스로서는 60나노급 기술 이전마저도 핵심기술 유출 논란에 휘말려 어려움을 겪고 있는 상황이다.

후발 D램 생산기업들의 합종연횡이 숨가쁘게 진행되고 있지만 정작 1위 자리를 수성해야 할 삼성전자는 특검수사에 발이 묶여 이렇지도 저렇지도 못하고 있다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2008/03/04>